

# I-line Stepper 管理規則

108.03.12 修訂

1. 此機台開放等級為 **B2 級**，使用者經訓練且通過考核後可自行操作。
2. 申請使用者須先通過 TRACK 考核滿 1 個月後，才可以申請考核 I-line stepper（許進財先生 ext:7648；mail：cthsu@narlabs.org.tw），一旦 TRACK 被停權，則同時取消 I-line stepper 使用權。
3. 為維持委託代工出貨進度順暢，於上班時段（上午 8：00 至下午 6：00）NDL 員工有優先使用權。如欲在上班時段使用機台，必須先徵求現場 operator 同意之後，方可使用；若現場無 operator，可先行使用，但於使用中若 operator 出現且欲使用機台，operator 有權要求使用者中止使用。
4. 每次使用須詳實填寫機台使用紀錄表，如有闕漏不實者，將視情節依 TSRI 規定議處。
5. 關於曝光後線寬的量測，由使用者自行操作 L06 CD SEM 量測。
6. 曝光檔名與內容請自行牢記，TSRI 不負記憶檔名與內容之責任。
7. 為活化硬碟空間，機台每年 2 月及 8 月進行曝光檔案清理，使用者請於 1 月底及 7 月底前將欲保留的檔案名稱列表繳交機台負責人，若因未繳交或是表列遺漏以致檔案遭刪除，使用者請自負責任，不得異議。
8. 曝多層圖形，如果第一層為離子佈值阻擋層，請另行作零層曝光（ILINEMARK-C0.JOB）與蝕刻（蝕刻深度大於 100 nm）。
9. 標準製程基材為：單面拋光 6 吋單平邊矽晶圓，平邊長度 57.5 mm，厚度 675 $\mu$ m（晶圓規格需與 NDL 規格相同），非標準製程基材請與工程師探討。
10. 標準製程光阻劑為 Sumitomo PFI38A5 阻劑(厚度 850 nm)、PFI89 阻劑(厚度 2100 nm)與 PFI245 阻劑(厚度 420 nm)。
11. 本機台最小解析為 0.35  $\mu$ m L/S pattern、0.3 $\mu$ m Line pattern 與 0.4 $\mu$ m hole pattern，若有其他特殊需求請洽工程師。
12. 機台劑量設定範圍：500 ~ 4000 J/M<sup>2</sup>，focus 設定範圍：+3~-3  $\mu$ m。未經許可，不可私自設定超過規定之值，造成機台有損傷之虞。
13. 嚴禁使用其他基材或阻劑，如欲使用其他基材或阻劑，須提出相關之書面說明，並經機台負責人核准後，方可使用。
14. 本機有關破片、4 吋與 2 吋等曝光製程，請洽工程師。